

# Fiche d'application n° 24

## Caractérisation d'un dépôt SiON sur un substrat silicium

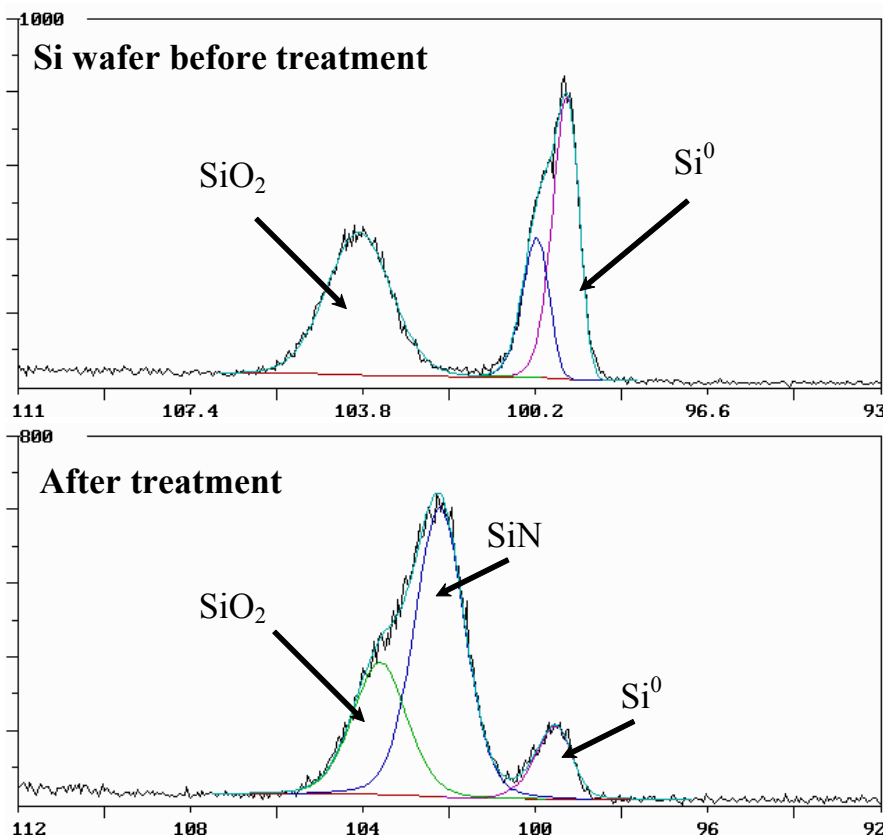
V2

**Objet :** Caractérisation d'un dépôt de SiON sur un wafer de silicium : étude des formes chimiques

**Technique mise en œuvre :** **ESCA**

- ✓ Profondeur d'analyse < 10 nm
- ✓ Quantification du rapport N/Si et O/Si
- ✓ Formes chimiques du silicium

### Résultats :



	non traité	traité
Si <sup>0</sup>	54	11
SiN	-	60
SiO <sub>2</sub>	46	29

### Conclusion :

Quantification de la composante SiN, à partir de l'étude de l'environnement chimique du silicium